

1
2

学院概况

- 学院简介
- 现任领导
- 机构设置
- 师资队伍
- 校园风光
- 硕士导师

 [教务系统](#)

 [科研系统](#)

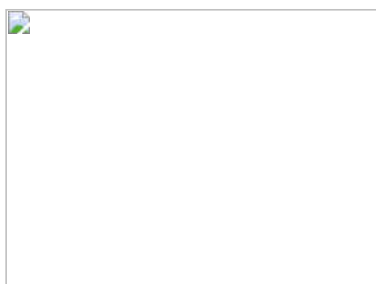
 [学院微信](#)

 [学院信箱](#)

师资队伍

郭宝增

添加时间 2016/1/17 20:03:21 浏览次数 1408 次



个人简介

郭宝增，男，教授。1982年年年毕业于河北大学，微电子专业。有：1982年毕业后留校，在河北大学电子信息工程学院工作，其中在英国利兹大学作访问学者，2000年-2001年在美国伊利诺伊大学(UIUC)作访问学者。现为电子科学与技术专业硕士研究生指导教师

研究方向

集成电路设计，半导体器件特性及模拟研究。

科研项目

1. 河北省自然科学基金项目：GaN 金属氧化物半导体场效应晶体管导电沟道载流子输运特性的研究(2009-2011)
2. 河北省教育厅项目：GaN MOSFET电沟道载流子输运特性的研究（2008-2010），主持人
3. 河北省教育厅项目：氧化锌太阳异质结太阳能电池研究（2003-2006），主持人

代表论文

1. Baozeng Guo, Umberto Ravaioli, Maritin Staedele. Full Band Monte Carlo Calculations of Ve Characteristics of Wurtzite ZnO. Computer physics communication 2006, 175(7): 482-486 [SCI]
2. Guo Baozeng, Guo Hui, Zhang Suoliang, Song Dengyuan. Simulation study of GaN n-MOSFET dimensional full band. 2010 ,Physica B, 45(24):4925-4930 [SCI收录]
3. Baozeng Guo,Umberto Ravaioli, Dengyuan Song. Properties of wurtzite GaN MESFETs studied by a three-dimensional full band Monte Carlo approach. Microelectronics Journal, 2004 35(2):176-123 [SCI收录]
4. Guo Baozeng, Umberto Ravaioli Differential Negative Resistance Effect of Output Characteristics of Sub-micrometer Wurtzite AlGaIn/GaN MODFETs 《Science in China F》(Series F) 2003. Vol. 46 No. 6:568 [SCI收录]
5. 郭宝增 Umberto Ravaioli. 深亚微米纤锌矿相AlGaIn/GaN MODFET输出特性的微分负阻效应 《中国物理》2003. Vol. 33 No.6:568

6. Guo Baozeng, Gong Na Yu Fu-qiang. Calculations of two dimensional electron gas distributio AlGa_N/Ga_N material system. Chinese Physics B. 2008, 17(1):290-295 [SCI收录]
7. 郭宝增, 张锁良, 刘鑫. 纤锌矿相Ga_N电子高场运输特性的Monte Carlo模拟研究. 物理学报, 2011,60 (6) : 068701 [SCI收录]
8. 郭宝增,Umberto Ravaioli 用全带Monte Carlo 方法模拟 Ga_N和ZnO特性 《物理学报》 2002. 51 2348 [SCI收录]
9. 郭宝增, 宫娜, 师建英. 纤锌矿相Ga_N空穴运输特性的Monte Carlo模拟研究. 物理学报 2006, 55(5) [SCI收录]
10. 郭宝增, 孙荣霞, Umberto Ravaioli. 用二维全带组合Monte Carlo方法模拟纤锌矿相Ga_N静电感应晶体, 《电子学报》 2003. Vol. 31 No.8: 1121-1124[EI收录]
11. 郭宝增 王永青 宗晓萍 孙荣霞 宋登元 Umberto Ravaioli Maritin Staedele, ZnO材料的电子运输特性报》 2003. 24(7): 723-728[EI收录]
12. Guo Baozeng Wang Yongqing et al, Comparison between three-valley model and full band mc Carlo simulation of bulk wurtzite Ga_N (英文), 《半导体学报》 2002. 23(2): 113-11[EI收录]
13. Guo Baozeng, Umberto Ravaioli ,Song Dengyuan Two dimensional full band and ensemble Mc simulation of wurtzite gan mesfets, 2002 Conference on Optoelectronic and Microelectronic Mi Devices, Sydney, Australia, 11-13, December 2002. 32] [EI收录]
14. Guo Baozeng Umberto Ravaioli, Two dimensional Monte Carlo simulation MODFET 《Journal Computational electronics》 2002.1 (3): 309-311
15. Guo Baozeng,Gong Na and Wang Jinhui Designing Leakage-Tolerant and Noise-Immune Enhai Power Wide OR Dominos in Sub-70nm CMOS Technologies[J]. Chinese Journal of semiconducto 2006,27(5):804-811 [EI收录]
16. Guo Baozeng, Gong Na Wang Jin-hui ,Leakage current cgaracteristics of footed dual Vt domir innanometer CMOS technologies.2006 8th international conference on solid-state and integrat technology proceedings, 260-262. Oct23-26,2006,Shanghai,China [EI收录]
17. Guo Baozeng, Nui Li,Lui Zhiming, Implementation of 2-D DCT based on FPGA Proceedings of SPIE(international conference on image processing and pattern recognition in industrial engine 收录]
18. 郭宝增,王志宇. Monte Carlo 模拟纤锌矿材料中粒子最终态的确定. 固体电子学研究进展. 2005, 21
19. 郭宝增 师建英 宫娜. Ga_N肖特基SIT的Monte Carlo模拟. 固体电子学研究进展. 2007,27(1):14-17[EI
20. Dengyuan Song and Baozeng Guo. Electrical properties and carrier transport mechanisms of n-ZnO/SiO₂/ r eterojunctions with native or thermal oxide interlayers J. Phys. D: Appl. Phys. 2009, 42 (2) : 1-8 [SCI收录]

获奖情况

1. Ca_N、ZnO材料和器件的Monte Carlo模拟研究。2009年获得省自然科学三等奖. 主持人
2. 氧化锌/单晶硅异质结太阳能电池制备及电学和光伏特性的研究,获保定市科技进步一等奖. 排名第二
3. 电气信息学科2+2培养方案的研究与实践。2004年获河北省教学成果三等奖. 主持人